		Формат	Зона	Поз.	Обозна чение	2	Наименование 🕺 Приме-	
ЭН.	13.002	DEUIL (60707 004 55					<u>Документация</u>	
примен.	PEYH. 94 16 13.002	<i>A2</i>			РЕУН.468323.001 СБ		Сборочный чертеж	
Перв.	hE Al	*/			PEYH.468323.001 33		Схема электрическая */АЗ,А4	
							принципиальная	
		A4			РЕУН.468323.001 ПЭЗ		Перечень элементов	
N		*/			РЕУН.468323.001 ВП		Ведомость покумных изделий *1,43,44	
Справ. 1								Сборочные единицы
		<u> </u>		2	PEYH.687253.003		Плата печатная 1	
							<u>Прочие изделия</u>	
Подп. и дата				5			Резонатор ABSO7-120-32.768КНZ-Т 1 BQ1 фирма Abracon, США	
Инв. И дубл.				7			Резонатор NX2520SA-16MHZ-STD-CSW-5 1 BQ2 фирма NDK, Япония	
Взам. инв. И								
Подп. и дата		Изм	1/10	CM.	N докум. Подп. Дата		PEYH.468323.001	
Инв. Иподл.		Раз Пр Н.к	гра. 10в.	δ. [7] <u> </u> np.	Тоокун. Пооп. дата Подлесный Павликов		Лит. Лист Листов ПЛАПА ЦПРАВЛЕНИЯ Формат А4	

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
			9		Конденсатор GRM21BR60J226ME39L	1	<i>C24</i>
					фирма Murata Manufacturing, Япония		
					Конденсаторы фирма Yageo, Тайвань		
			12		CC0603JRNP09BN120	4	<u> </u>
			14		CC0603KPX7R9BB103	6	C25,C26,C2 C30,C51,C5
			16		CC0603KRX7R9BB333	1	C21
Подп. и дата			18		CC0603MRX5R7BB105	16	C19,C33-C4
Инв. N дубл.			20		CC0603ZRY5V9BB104	24	C3,C4,C7-C
Взам. инв. N							C20,C22,C2 C27,C28,C C32,C48-C. C53-C55
Подп. и дата							
Инв.N подл.	Изм	<i></i>	ист.	N°докум. Подп. Дата	PEYH.468323.001		/luc

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
				Конденсаторы фирма Үадео, Тайвань		
		23		CC0805KKX7R7BB475	1	<u>C13</u>
		25		CC420 CVVVCD2DD40 C	2	545 540
		25		CC1206KKX5R8BB106	2	<u>C15,C18 </u>
		27		Микросхема K7805-500R3	1	DA2
				фирма Mornsun Power, Китай		
		29		Микросхема LM2904DR2G	2	DA5,DA6
				фирма ON Semiconductor, США		
				фирма ST Microelectronics, Швейцария		
		32		Микросхема L 7805CV-DG	1	DA1
		34		Микросхема TS4962IQT	1	DA4
		7/				247
		36		Микросхема TLV70233DBVT фирма Texas Instruments, США	1	DA3
		38		Микросхема CP2102N-A02-GQFN20R	1	DD3
	_			фирма Silicon Labs, США		1/10

	Формат Зана	703.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
_	+	40		Микросхема MAX232ID	3	DD4-DD6
				фирма Texas Instruments, США		
	+			Микросхемы фирма Microchip Technology, США		
				пакросясны фарна тистостир тестносоду, сшл		
	+	43		MCP4011-502E/MS	1	DD2
		45		24LC04B/SN	1	DD7
ווסטוו. עי טעוווע		47		Микроконтроллер STM32F4O1RET6 фирма ST Microelectronics, Швейцария	1	DD1
VIAO. N OGON.		49		Предохранитель MF-SMDF050-2 фирма Bourns, США	1	FU1
7 A. COTO. T. D.C.C.				Светодиоды фирма Kingbright, Тайвань		
\sqcap	+	52		APT1608CGCK	1	HL1
		54		APT1608EC	4	HL2-HL5
MHÖ.N NOGN.	13M. /	Ducm N	Р°докум. Подп. Дата	PEYH.468323.001		//

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Kon	Приме- чание
	\dashv						
-	\dashv		56		Ферритовая бусина ВLM18TG102TN1D	1	L1
	\dashv				фирма Murata, Япония		
-	_						
-					Резисторы фирма Үадео, Тайвань		
	-						
			59		RC0603FR-070RL	12	R9,R14,R1 <u>5</u>
							R24,R25,R4
							R46,R50,R5
							R62,R64,
-	-						R66
<u> </u>							
дата			61		RC0603FR-0710RL	2	R38,R39
Подп. и о			.7			,	
	\dashv		63		RC0603FR-0722RL	4	R48,R49,R5
Ν ἀψδη.	_						R57
MHB. N							
			65		RC0603FR-071KL	8	R10,R17-R
HB. N							R42,R47,R5
Взам. инв.	_						R60
שמ							
Подп. и дата			67		RC0603FR-071K5L	2	R51,R61
Jh.							
Инв.N подл.	!		cm N°ô	докум. Подп. Дата	PEYH.468323.001		/lui

	Формат	Зона	Поз.	Оδозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
			70		RC0603FR-074K7L	4	R20,R21,
							R56,R58
			72		RC0603FR-0710KL	21	R3,R6,R11,
	H		12		INCOODS IN -07 IONE	21	R16,R26,
							R29-R31,
							R34-R37,R4
							R43,R63,R6
							R67-R71
			74		RC0603FR-0720KL	4	R32,R33,R4
							R44
дата							
Подп. и							
01			76		RC0603FR-0722KL	1	R54
JQV.							
И дубл.							
NHB.	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{eta}}}$		78		RC0603FR-0727KL	2	R27,R28
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\vdash						
Взам. инв.	H		80		RC0603FR-0747KL	1	R53
Вза	+		33		ACOUSIN OFFINE	<u> </u>	ردار
ا ا							
и дата							<u> </u>
Nodn. ı							
\vdash	\perp						
лоди.							<u> </u>
Инв.N подл.		L		F	PEYH.468323.001		Nuc
<u> </u>	Изм	. /Iu	CM	N°докум. Подп. Дата	Форми		6

Формар	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
				Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
		85		RC0603FR-07100KL	17	R1,R2,R4,R
						R7,R8,R12,R
-	<u> </u>					R72-R80
		87		RC0603FR-07150KL	2	R22,R23
		89		Диод MBR130LSFT1G	1	VD1
				фирма ON Semiconductor, США		
		91		Диод SMAJ15A-13-F	1	VD2
				фирма Diodes Incorporated, США		
		93		Диод SM05T1G	6	VD3-VD8
				фирма ON Semiconductor, США		
		95		Транзисторы 2N7002К	11	VT1-VT11
				фирма ON Semiconductor, США		
	+					
	 					
Из	3M. /IL	<i>ICITI</i> N	У°докум. Подп. Дата	PEYH.468323.001		/lu

Формат	Зона	Поз.	Оδозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
				Вилки фирма Connfly Electronic, Китай		
		100		DS1066-02MVW6	6	X1,X2,X6
						X15-X17
		102		DS1066-03MVW6	1	X13
		104		DS1066-04MVW6	1	X3
		106		DS1069-2MVW6X	1	X5
aama		108		DS1069-4MVW6X	1	X14
		110		Вилка L-KLS1-207C-2,50-2-10-S,	1	X4
мно. N ayon. 				фирма KLS Electronic, Китай		
 				Вилки фирма Molex, США		
1 P3dM. UH0.		113		70246-1201	1	X7
поап. и аата						
I lodn.		115		87834-0819	3	X8-X10
MHO.N NOON.	<u> </u>			PEYH.468323.001		<i>//</i> c

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
			118		Розетка 1050170001	2	X11,X12
					фирма Molex, США		
дата							
Подп. и							
И дубл.							
3 N C							
Инв.	_						
~	\vdash						
Взам. инв. N							
Взаг	\bot						
Подп. и дата							
оди. п							
<i>Jh</i> .							
Инв.N подл.		F	\top	DI		!	Лист
NHC	Изм	. /IU	ст	N°докум. Подп. Дата	E YH.468323.001	_	9

				/lucm pea	гистрации	изменений			
Изм.		пера листов	в (страниц)	i	Всего листов	Номер документа	Входящий номер сопрово-	Подпись	Дат
	ИЗМЕНЕН- НЫХ	3аменен- ных	новых	анулиро- ванных	(страниц) в документе	документа	номер сопрово- дительного документа и дата		
Изм.	Лист N до	кум. Поді	п. Дата	F	PEYH.4	68323.	001		10
1		g 11001	1,000,00	Копировал			Формат л	44	